

技术及应用

浮栅ROM器件 γ 射线、X射线和中子辐射效应实验研究

何宝平, 张凤祁, 姚志斌

西北核技术研究所, 陕西 西安 710613

收稿日期 2006-3-6 修回日期 2006-9-5 网络版发布日期: 2007-7-30

摘要 本工作涉及浮栅ROM器件AT29C256的 γ 射线、X射线和反应堆快中子辐照实验测量。测量结果表明, 浮栅ROM器件 γ 射线、X射线和快中子辐照效应是典型的总剂量效应。错误发生存在剂量阈值, 开始出错时的错误数及错误地址不确定, 错误数随辐照剂量或注量的增大而增加。

关键词 [浮栅ROM器件](#) [\$\gamma\$ 射线](#) [X射线](#) [中子](#) [总剂量效应](#)

分类号 [TN386.1](#)

Experimental Study on Irradiation Effects of γ , X and Neutron in Floating ROM Devices

HE Bao-ping, ZHANG Feng-qi, YAO Zhi-bin

Northwest Institute of Nuclear Technology, Xi'an 710613, China

Abstract γ -ray, X-ray and neutron irradiation effects of floating ROM devices were measured. The measured results show γ -ray, X-ray and neutron irradiation effects of floating ROM devices are total dose effects. There is a dose threshold when error occurs. At the beginning of error or occurrence, the error address and data are random, and the data errors number goes up with the increase of dose or fluence.

Key words [floating ROM device](#) [\$\gamma\$ -ray](#) [X-ray](#) [neutron](#) [total dose effect](#)

DOI

通讯作者

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(138KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中包含“浮栅ROM器件”的相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [何宝平](#)
- [nbsp](#)
- [张凤祁](#)
- [nbsp](#)
- [姚志斌](#)